



特点:

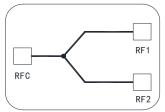
● 频率范围: 0.5~2GHz

● 插入损耗: 0.8dB

● 输入/输出: 50Ohm 匹配

● 芯片尺寸: 1.5×1.05×0.1mm

# 功能框图:



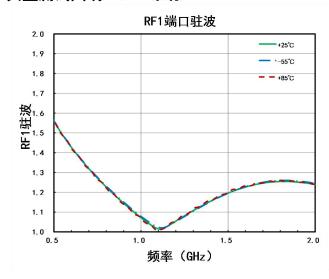
#### 产品简介:

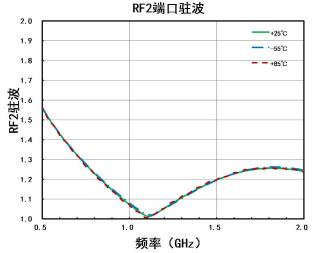
YDC8001 是一款采用 GaAs pHEMT 工艺设计制造的两路功分芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理,适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺,芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

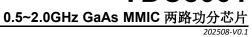
#### 性能参数:(50Ω系统)

	符号	参数值				
参数名称		常温(+25℃)			全温	单位
		MIN	TYP	MAX	-55°C∼+85°C	
频率范围	f	0.5	-	2.0	0.5~2.0	GHz
插入损耗	IL	-	0.8	1.5	≤1.7	dB
端口驻波	VSWR	-	1.4	1.8	≤2.0	-
隔离度	ISO	20	25	-	≥18	dB
幅度不平衡	AU	-	0.01	0.1	≤0.2	dB

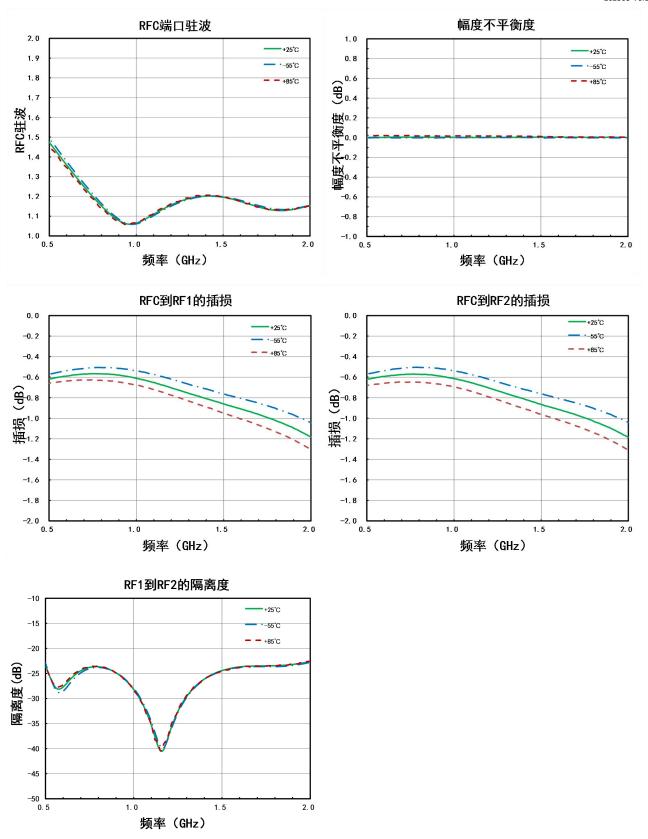
#### 典型测试曲线: (50Ω系统)







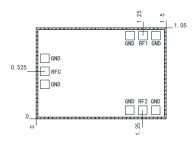






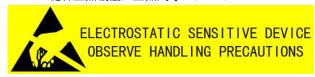


外形尺寸图:



注: 1.单位: mm;

- 2.芯片背面镀金,背面接地;
- 3.外形尺寸公差: ±0.05mm;
  - 4.键合压点镀金,压点尺寸: 0.1×0.1mm。



#### 引脚定义:

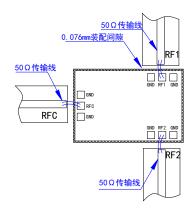
符号	描述		
RFC	射频输入,内部无隔直		
RF1	射频输出 1,内部无隔直		
RF2	射频输出 2, 内部无隔直		
GND	接地,芯片底部需接地良好		
芯片背面	接地,芯片底部需接地良好		

#### 极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+27dBm
装配温度	+300℃, 20s
工作温度	-55°C∼+85°C
贮存温度	-65°C∼+150°C

超过以上任何一项极限参数,可能造成器件永久损坏。

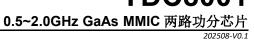
#### 推荐装配图:



注:射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸,典型的装配间隙是  $0.076\sim0.152$ mm,使用  $\Phi$  25um 双金丝键合,建议 金丝长度  $250\sim400$ um。

#### 产品使用注意事项:

- 1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储,在超净环境装配使用。
- 2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆,芯片表面容易受损,不能用干或湿化学方法清洁芯片表面,使用时须小心。
- 3. 芯片粘结装配时,需考虑热膨胀应力对芯片的影响,芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上,如可伐、钨铜或钼铜垫片上,避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
- 4. 芯片使用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过+300℃,时间不能超过 20 秒),使之充分接地。
- 5. 芯片射频端口使用 25um 双金丝键合,建议金丝长度 0.25~0.40mm (10~16 mils)。
- 6. 在存储和使用过程中注意防静电,烧结、键合台接地良好。





## 附 1: 文件签审

拟制:	张婷婷	日期:	2025. 08. 05
审核:		日期:	
产品审查:		日期:	
工艺审查:		日期:	
标准化:		日期:	
批 准:		日期:	
质量归档:		日期:	

# 附 2: 规格书修订记录

版本	日期	拟制	主要更改内容	变更单号
V0.0	2025.01.01	李峰	初版	/
V0.1	2025.07.29	李峰	外部型号由原 SX8011 改为 004sip 使用的 SX8001	/

## 附 3: 规格书模板标记

模板版本: 2025 版 定版时间: 2024.12.28